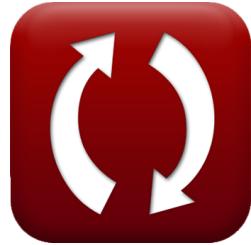


[calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com)[unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

# Caratteristiche del MOSFET Formule

[Calcolatrici!](#)[Esempi!](#)[Conversioni!](#)

Segnalibro [calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com), [unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

La più ampia copertura di calcolatrici e in crescita - **30.000+ calcolatrici!**  
Calcola con un'unità diversa per ogni variabile - **Nella conversione di unità  
costruita!**

La più ampia raccolta di misure e unità - **250+ misurazioni!**

Sentiti libero di CONDIVIDERE questo documento con i  
tuoi amici!

[Si prega di lasciare il tuo feedback qui...](#)



# Lista di 16 Caratteristiche del MOSFET Formule

## Caratteristiche del MOSFET ↗

### 1) Conduttanza del canale del MOSFET utilizzando la tensione da gate a source ↗

**fx**  $G = \mu_s \cdot C_{ox} \cdot \frac{W_c}{L} \cdot (V_{gs} - V_{th})$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

**ex**  $6.0724\text{mS} = 38\text{m}^2/\text{V}\cdot\text{s} \cdot 940\mu\text{F} \cdot \frac{10\mu\text{m}}{100\mu\text{m}} \cdot (4\text{V} - 2.3\text{V})$

### 2) Conduttanza nella resistenza lineare del MOSFET ↗

**fx**  $G = \frac{1}{R_{ds}}$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

**ex**  $6.024096\text{mS} = \frac{1}{0.166\text{k}\Omega}$

### 3) Effetto del corpo sulla transconduttanza ↗

**fx**  $g_{mb} = X \cdot g_m$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

**ex**  $0.1\text{mS} = 0.2 \cdot 0.5\text{mS}$



## 4) Fattore di amplificazione nel modello MOSFET a piccolo segnale

**fx**  $A_f = g_m \cdot R_{out}$

[Apri Calcolatrice !\[\]\(cbe80b694ebd74fcfe136a095b608235\_img.jpg\)](#)

**ex**  $2.25 = 0.5\text{mS} \cdot 4.5\text{k}\Omega$

## 5) Frequenza di transizione del MOSFET

**fx**  $f_t = \frac{g_m}{2 \cdot \pi \cdot (C_{sg} + C_{gd})}$

[Apri Calcolatrice !\[\]\(3e2231b1ad3ca8da8658228c00dd08e0\_img.jpg\)](#)

**ex**  $5.249174\text{Hz} = \frac{0.5\text{mS}}{2 \cdot \pi \cdot (8.16\mu\text{F} + 7\mu\text{F})}$

## 6) Guadagno di tensione data la resistenza di carico del MOSFET

**fx**  $A_v = g_m \cdot \frac{\frac{1}{R_L} + \frac{1}{R_{out}}}{1 + g_m \cdot R_s}$

[Apri Calcolatrice !\[\]\(0d5ec72f61334709c3fc9450209b754f\_img.jpg\)](#)

**ex**  $0.026099 = 0.5\text{mS} \cdot \frac{\frac{1}{0.28\text{k}\Omega} + \frac{1}{4.5\text{k}\Omega}}{1 + 0.5\text{mS} \cdot 8.1\text{k}\Omega}$

## 7) Guadagno di tensione data la tensione di drain

**fx**  $A_v = \frac{i_d \cdot R_L \cdot 2}{V_{eff}}$

[Apri Calcolatrice !\[\]\(b64b40baaee5acddc1eab8538ba84754\_img.jpg\)](#)

**ex**  $0.026353 = \frac{0.08\text{mA} \cdot 0.28\text{k}\Omega \cdot 2}{1.7\text{V}}$



## 8) Guadagno di tensione massimo al punto di polarizzazione ↗

**fx**  $A_{vm} = 2 \cdot \frac{V_{dd} - V_{eff}}{V_{eff}}$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

**ex**  $7.941176 = 2 \cdot \frac{8.45V - 1.7V}{1.7V}$

## 9) Guadagno di tensione massimo dato tutte le tensioni ↗

**fx**  $A_{vm} = \frac{V_{dd} - 0.3}{V_t}$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

**ex**  $7.990196 = \frac{8.45V - 0.3}{1.02V}$

## 10) Guadagno di tensione usando il segnale piccolo ↗

**fx**  $A_v = g_m \cdot \frac{1}{\frac{1}{R_L} + \frac{1}{R_{fi}}}$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

**ex**  $0.026377 = 0.5mS \cdot \frac{1}{\frac{1}{0.28k\Omega} + \frac{1}{0.065k\Omega}}$

## 11) Larghezza del canale da gate a sorgente del MOSFET ↗

**fx**  $W_c = \frac{C_{oc}}{C_{ox} \cdot L_{ov}}$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

**ex**  $9.957028\mu m = \frac{3.8e-7\mu F}{940\mu F \cdot 40.6\mu m}$



## 12) Tensione di polarizzazione del MOSFET

**fx**  $V_{be} = V_{bias} + V_{de}$

[Apri Calcolatrice !\[\]\(e2376d476d06eb31946dc01a69a4403a\_img.jpg\)](#)

**ex**  $8.3V = 5.3V + 3V$

## 13) Tensione di saturazione del MOSFET

**fx**  $V_{ds(s)} = V_{gs} - V_{th}$

[Apri Calcolatrice !\[\]\(0b5e7e25e8775f7e7e80906ada4f0021\_img.jpg\)](#)

**ex**  $1.7V = 4V - 2.3V$

## 14) Tensione di soglia del MOSFET

**fx**  $V_{th} = V_{gs} - V_{eff}$

[Apri Calcolatrice !\[\]\(bd3b31712ad9bab5a241210fa6925cdd\_img.jpg\)](#)

**ex**  $2.3V = 4V - 1.7V$

## 15) Transconduttanza MOSFET data capacità di ossido

**fx** 
$$g_m = \sqrt{2 \cdot \mu_n \cdot C_{ox} \cdot \left( \frac{W_t}{L_t} \right) \cdot I_d}$$

[Apri Calcolatrice !\[\]\(7bc43b319a082987e20f7bf78f4bab80\_img.jpg\)](#)

**ex** 
$$2.286578S = \sqrt{2 \cdot 30m^2/V*s \cdot 3.9F \cdot \left( \frac{5.5\mu m}{3.2\mu m} \right) \cdot 0.013A}$$



**16) Transconduttanza nei MOSFET****Apri Calcolatrice** ↗

**fx** 
$$g_m = \frac{2 \cdot i_d}{V_{ov}}$$

**ex** 
$$0.5 \text{mS} = \frac{2 \cdot 0.08 \text{mA}}{0.32 \text{V}}$$



# Variabili utilizzate

- $A_f$  Fattore di amplificazione
- $A_v$  Guadagno di tensione
- $A_{vm}$  Guadagno di tensione massimo
- $C_{gd}$  Capacità di gate-drain (*Microfarad*)
- $C_{oc}$  Capacità di sovrapposizione (*Microfarad*)
- $C_{ox}$  Capacità dell'ossido (*Microfarad*)
- $C_{ox}$  Capacità dell'ossido (*Farad*)
- $C_{sg}$  Capacità del gate della sorgente (*Microfarad*)
- $f_t$  Frequenza di transizione (*Hertz*)
- $G$  Conduttanza del canale (*Millisiemens*)
- $g_m$  Transconduttanza (*Millisiemens*)
- $g_m$  Transconduttanza nei MOSFET (*Siemens*)
- $g_{mb}$  Transconduttanza corporea (*Millisiemens*)
- $i_d$  Assorbimento di corrente (*Millampere*)
- $I_d$  Assorbimento di corrente (*Ampere*)
- $L$  Lunghezza del canale (*Micrometro*)
- $L_{ov}$  Lunghezza di sovrapposizione (*Micrometro*)
- $L_t$  Lunghezza del transistor (*Micrometro*)
- $R_{ds}$  Resistenza lineare (*Kilohm*)
- $R_{fi}$  Resistenza finita (*Kilohm*)
- $R_L$  Resistenza al carico (*Kilohm*)



- **R<sub>out</sub>** Resistenza di uscita (*Kilohm*)
- **R<sub>s</sub>** Resistenza alla fonte (*Kilohm*)
- **V<sub>be</sub>** Tensione di polarizzazione istantanea totale (*Volt*)
- **V<sub>bias</sub>** Tensione di polarizzazione CC (*Volt*)
- **V<sub>dd</sub>** Tensione di alimentazione (*Volt*)
- **V<sub>de</sub>** Tensione CC (*Volt*)
- **V<sub>ds(s)</sub>** Tensione di saturazione di drain e source (*Volt*)
- **V<sub>eff</sub>** Tensione effettiva (*Volt*)
- **V<sub>gs</sub>** Tensione gate-source (*Volt*)
- **V<sub>ov</sub>** Tensione di overdrive (*Volt*)
- **V<sub>t</sub>** Tensione termica (*Volt*)
- **V<sub>th</sub>** Soglia di voltaggio (*Volt*)
- **W<sub>c</sub>** Larghezza del canale (*Micrometro*)
- **W<sub>t</sub>** Larghezza del transistor (*Micrometro*)
- **μ<sub>n</sub>** Mobilità elettronica (*Metro quadrato per Volt al secondo*)
- **μ<sub>s</sub>** Mobilità degli elettroni sulla superficie del canale (*Metro quadrato per Volt al secondo*)
- **X** Modifica della soglia alla tensione di base



# Costanti, Funzioni, Misure utilizzate

- **Costante:** **pi**, 3.14159265358979323846264338327950288

*Costante di Archimede*

- **Funzione:** **sqrt**, sqrt(Number)

*Una funzione radice quadrata è una funzione che accetta un numero non negativo come input e restituisce la radice quadrata del numero di input specificato.*

- **Misurazione:** **Lunghezza** in Micrometro ( $\mu\text{m}$ )

*Lunghezza Conversione unità* ↗

- **Misurazione:** **Corrente elettrica** in Millampere (mA), Ampere (A)

*Corrente elettrica Conversione unità* ↗

- **Misurazione:** **Frequenza** in Hertz (Hz)

*Frequenza Conversione unità* ↗

- **Misurazione:** **Capacità** in Microfarad ( $\mu\text{F}$ ), Farad (F)

*Capacità Conversione unità* ↗

- **Misurazione:** **Resistenza elettrica** in Kilohm ( $\text{k}\Omega$ )

*Resistenza elettrica Conversione unità* ↗

- **Misurazione:** **Conduttanza elettrica** in Millisiemens (mS), Siemens (S)

*Conduttanza elettrica Conversione unità* ↗

- **Misurazione:** **Potenziale elettrico** in Volt (V)

*Potenziale elettrico Conversione unità* ↗

- **Misurazione:** **Mobilità** in Metro quadrato per Volt al secondo ( $\text{m}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ )

*Mobilità Conversione unità* ↗



## Controlla altri elenchi di formule

- Caratteristiche del MOSFET

Formule 

Sentiti libero di CONDIVIDERE questo documento con i tuoi amici!

### PDF Disponibile in

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

5/10/2024 | 9:34:05 AM UTC

[Si prega di lasciare il tuo feedback qui...](#)

